

シリコントランジスタ パワートランジスタ
 ダーリントントランジスタアレイ
 プリンタ・小形モータ駆動用

FT5763M/5766M

*外形寸法図及び結線図はP453~P455を参照願います。

■最大定格 (周囲温度25°C)

項 目	記 号	条 件	定 格		単 位
			FT5763M	FT5766M	
保 存 温 度	T_{stg}		-55~+150	-55~+150	°C
接 合 部 温 度	T_j		+150	+150	°C
コレクタ・ベース電圧	V_{CEO}		150	150	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}		5	5	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}		100	100	V
コレクタ電流	I_C		±1.5	±1.5	A
	I_{CW}	PW ≤ 1ms, D.R. ≤ 30%	±3	±3	A
ベース電流	I_B		0.1	0.1	A
ダイオード順電流	I_{FM}	PW ≤ 0.5ms, D.R. ≤ 15% (注1)	1.5	-	A
	I_{FM}	PW ≤ 100ms, 単発 (注1)	3	-	A
ダイオード逆電圧	V_S	(注1)	110	-	V
コレクタ損失	P_C	$T_a = 25°C$, 1素子動作	1.5	1.5	W
総コレクタ損失	P_T	$T_a = 25°C$, 4素子動作	3.5	3.5	W
総コレクタ損失	P_T	$T_a = 25°C$, 4素子動作	17	17	W

(注1) フライバック電圧吸収用ダイオード

■電気的特性 (周囲温度25°C)

1. ダーリントントランジスタ1素子当り (FT5763M, FT5766M)

項 目	記 号	条 件	規 格			単 位
			最小値	標準値	最大値	
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 100\mu A, I_E = 0$	150	-	-	V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 70mA, I_C = 0$	5	-	-	V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10mA, R_{th} = \infty \Omega$	100	-	-	V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CES}$	$I_C = 1mA, R_{th} = 100\Omega$ (注2)	110	-	-	V
コレクタレキ断電流	I_{CS0}	$V_{CE} = 100V, I_E = 0$	-	-	10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$I_C = 0.75A, V_{CE} = 5V$ (注3)	2000	6000	15000	-
	h_{FE2}	$I_C = 1.5A, V_{CE} = 5V$ (注3)	500	-	-	-
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 0.75A, I_B = 1.5mA$ (注3)	-	1.1	1.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$		-	1.6	2.0	V
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}	$V_{CE} = 30V$	-	0.5	μs
	蓄積時間	t_{stg}	$I_C = 0.75A$	-	2.1	μs
	下降時間	t_f	$I_{B1} = -I_{B2} = 1.5mA$	-	0.4	μs

(注2) FT5763Mに適用

(注3) パルス測定 PW ≤ 300 μs , D.R. ≤ 6%

2. フライバック電圧吸収用ダイオード1素子当り (FT5763M)

項 目	記 号	条 件	規 格			単 位
			最小値	標準値	最大値	
順電圧	V_F	$I_F = 100mA$	-	-	1.0	V
逆電流	I_R	$V_R = 100V$	-	-	5	μA
逆電圧	V_R	$I_R = 10\mu A$	110	-	-	V

用電源や一子級小・マシウテ

FT5763M/5766M

標準特性曲線

